



(11) **EP 2 525 397 B8**

(12) **KORRIGIERTE EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**

(15) Korrekturinformation:
Korrigierte Fassung Nr. 1 (W1 B1)
Korrekturen, siehe
Bibliographie INID code(s) 84

(51) Int Cl.:
H01L 23/057 ^(2006.01) **H01L 23/373** ^(2006.01)
H01L 23/31 ^(2006.01)

(48) Corrigendum ausgegeben am:
25.11.2015 Patentblatt 2015/48

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
21.10.2015 Patentblatt 2015/43

(21) Anmeldenummer: **12003854.2**

(22) Anmeldetag: **16.05.2012**

(54) **Leistungshalbleiter**

Power semiconductor

Semi-conducteur de puissance

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO
PL PT RO RS SE SI SK SM TR

(30) Priorität: **17.05.2011 DE 202011100820 U**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
21.11.2012 Patentblatt 2012/47

(73) Patentinhaber: **IXYS Semiconductor GmbH**
D-68623 Lampertheim (DE)

(72) Erfinder:
• **Zschieschang, Olaf**
68519 Viernheim (DE)
• **Laschek-Enders, Andreas**
64625 Bensheim (DE)

(74) Vertreter: **Oppermann, Frank**
OANDO Oppermann & Oppermann LLP
Washingtonstrasse 75
65189 Wiesbaden (DE)

(56) Entgegenhaltungen:
WO-A1-2004/090977 WO-A2-03/071601
DE-A1- 19 625 240 US-A1- 2010 140 786

EP 2 525 397 B8

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).
